

專利權讓與公告：

銻鋁砷化銾鎵與砷化銾鎵之集基異質接面雙極性電晶體 (Heterojunction Bipolar Transistor Having (IN)(AL) Gaassb/Ingaas Base-Collector Structure)

有鑑於在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，企業掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積企業技術能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼；國立中央大學擬將其所擁有之優質專利，以讓與方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力及促進整體產業發展，並提昇研發成果運用效益。

公告主旨	專利權讓與遴選廠商公告： 銻鋁砷化銾鎵與砷化銾鎵之集基異質接面雙極性電晶體
公告時間	109 年 4 月 10 日
公告內容	一、專利權家族名稱： 銻鋁砷化銾鎵與砷化銾鎵之集基異質接面雙極性電晶體 (Heterojunction Bipolar Transistor Having (IN)(AL) Gaassb/Ingaas Base-Collector Structure) 1. 中華民國專利證書號 TW I341029 (本校編號 095054TW) 2. 美國專利證書號 US 7705361 (本校編號 095054US) 二、發明人：綦振瀛教授 (電機工程學系)、王聖瑜、陳書涵 三、廠商資格： 1.產業類別：電子與光電工程-矽基半導體技術 2.應具備之專門技術：電子與光電工程 3.應有之機具設備：無 4.應有之研究或技術人員：電子與光電工程相關技術人員 5.其他條件：無特殊限制 6.其餘應符合本校技術移轉相關規定。 四、申請方式：逕向研發處智權技轉組詢問相關資訊，同時間有多間廠商申請時，以價高者優先。 五、申請截止日期：108 年 4 月 22 日 17 時 00 分止
聯絡人	鄭智元 智權經理
聯絡電話	03-4227151 轉 27077
電子郵件	johnny@g.ncu.edu.tw

專利摘要資料：

1. TW I341029：<http://ipm.ncu.edu.tw/prod1.asp?ser=5221>
2. US 7705361：<https://patents.google.com/patent/US7705361>